










	<b>ZXMN10A11K</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	ZXMN10A11K
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 2.4A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">ZXMN10A11K.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 26850 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	ZXMN10A11K
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 2.4A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	26850 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-3
Verlustleistung (max)	2.11W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	350 mOhm @ 2.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	274pF @ 50V
Verpackung	Original-Reel®

ZXMN10A11K ist neu im Original, Suche ZXMN10A11K Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ZXMN10A11K Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage ZXMN10A11K: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>ZXMN10A09KTC</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 5A DPAK</p>	 <p><b>ZXMN10A11KTC</b> Displaytech MOSFET N-CH 100V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>ZXMN10A25G</b> DIODES ZXMN10A25G DIODES</p>	 <p><b>ZXMN10A11GTA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT223</p>
 <p><b>ZXMN10A25GTC</b> Z ZXMN10A25GTC Z</p>	 <p><b>ZXMN10A11G</b> DIODES ZXMN10A11G DIODES</p>	 <p><b>ZXMN10A09L</b> Diodes Diodes TO-252</p>	 <p><b>ZXMN10A11GTC</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT223</p>

### heiße Teile

Mehr

 ZXMHC10A07N8TC	 ZXMHC10A07T8TA	 ZXMHC3A01N8TC	 ZXMHC3A01T8TA	 ZXMHC6A07N8TC
 ZXMHC6A07T8TA	 ZXMHN6A07T8TA	 ZXMN0545G	 ZXMN10A07FTA	 ZXMN10A07ZTA
 ZXMN10A08	 ZXMN10A08DN8	 ZXMN10A08DN8TA	 ZXMN10A08DN8TC	 ZXMN10A08E6
 ZXMN10A08E6T	 ZXMN10A08E6TA	 ZXMN10A08E6TC	 ZXMN10A08G	 ZXMN10A08GTA
 ZXMN10A09K	 ZXMN10A09KTC	 ZXMN10A11G	 ZXMN10A11GTA	 ZXMN10A11GTC
 ZXMN10A11KTC	 ZXMN10A11KTC	 ZXMN10A25G	 ZXMN10A25GTA	 ZXMN10A25GTC
 ZXMN10A25K	 ZXMN10A25KTC	 ZXMN10B08E6	 ZXMN10B08E6TA	 ZXMN15A27KTC
 ZXMN2088DE6TA	 ZXMN20B28KTC	 ZXMN2A01E6TA	 ZXMN2A01FTA	 ZXMN2A01FTC
 ZXMN2A02N8	 ZXMN2A02N8TA	 ZXMN2A02N8TC	 ZXMN2A02X8TA	 ZXMN2A02X8TC
 ZXMN2A03E6	 ZXMN2A03E6TA	 ZXMN2A04DN8	 ZXMN2A04DN8TA	 ZXMN2A04DN8TC

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited